

تحضير و دراسة خصائص السيلسيورات الترايبية النادرة و للمعادن الانتقالية

ملخص

موضوع هذه الرسالة يتناول تحضير و دراسة الطبقات النانومترية الرقيقة للسيلسيورات الثنائية و الثلاثية للمعادن الانتقالية و الترايبية النادرة. حيث تم الحصول على عينات النظام الثنائي بواسطة الغرس الايوني لايونات الإيتريوم في درجات حرارة الغرفة (RT) بجرعة $2 \times 10^{17} Y^+ / cm^2$ و طاقة تساوي 195keV في مساند من السيليكون ذات الاتجاه (111) من النوع p, متبوعة بالمعالجة الحرارية عند درجات حرارة $600^\circ C$, $800^\circ C$ و $1000^\circ C$ لمدة 1 ساعة. تشكلت طبقات السيلسيورات الثلاثية Ni / Y / Si التي تشكل السلسلة الثانية من العينات ، عن طريق غرس أيونات الإيتريوم في ركيزة (111) Si بجرعة $8 \times 10^{16} Y^+ / cm^2$ عند الحرارة المخبرية و بطاقة مساوية إلى 200 كيلو فولت ، يتبعه ترسب طبقة من النيكل عن طريق الرش المغناطيسي في درجة حرارة الغرفة. بعد ذلك ، خضعت هذه العينات للمعالجة الحرارية عند درجات حرارة تتراوح بين $150^\circ C$ و $400^\circ C$ لمدة ساعة واحدة. انعراج الأشعة السينية (XRD) و مطيافية التشتت الخلفي لروثرفورد (RBS) ، مطيافية Raman و المجهر الإلكتروني الماسح (MEB) و مجهر القوة الذرية (AFM) هي التقنيات المستخدمة لدراسة خصائص العينات. بالنسبة للنظام Y/Si(111) أوضحت النتائج أن طبقات سيلسيورات الإيتريوم YSi_{2-x} تتشكل وتنمو على مساند السيليكون في بنية متعددة البلورات بشكل مستقل عن درجة الحرارة. بالنسبة لنظام Ni / Y / Si (111) ، سلطت الدراسة الضوء على تكوين العديد من السيلسيورات الثنائية والثلاثية التي تعكس التفاعل في الحالة الصلبة عند واجهة نظام Ni / Y / Si.

كلمات مفتاحية: العناصر الترايبية النادرة، سلسيورات الإيتريوم ، الفاصل البيني، الغرس الأيوني, DRX,

AFM, MEB, RBS